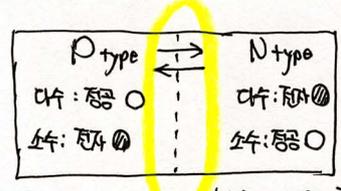


1주차. 목표인 전자공학.

### Diode - PN junction



농도에 의한 확산 "diffusion"

접합부(공핍) 전위장벽 → ex) 반도체 특성..

- Si : 0.7 eV
- Ge : 0.4 eV

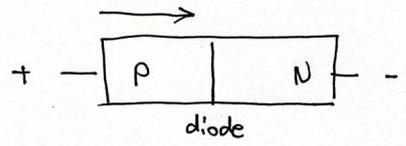
물질 = 원자 + 전자

전자 수와 정공 수 같음  
= 중성 상태.

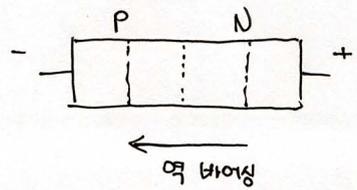
\* drift : 이동 (전자)

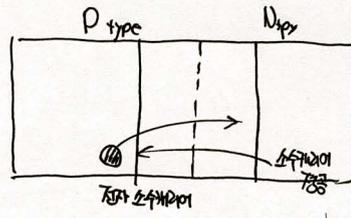
항복 < 애벌런치  
Break Down

순방향 바이어스 (forward) - 소자가 본래의 특성대로 동작하기 위한 전압.



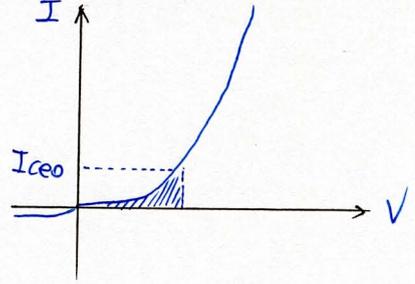
역방향 바이어스 (backward) biasing - 공핍층이 쏠려 넓어짐.





소수 캐리어에 의한 이동

부하 전류 (여포화 전류)



앞으로 배울 거임...

- 광 다이오드.
- Schottky ~
- tunnel Diode
- etc

